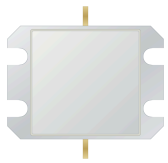
8500–9600 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 51 dBm (tipik)

LCT-8500-9600-PS51T · 8500–9600 MHz · GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü.

RF tablosundaki değerler: PSAT 51 dBm (tipik); Güç kazancı 9 dB (tipik); PAE 38 % (tipik). RF test koşulları: Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm.



CMW025B

Önce kapı, sonra dren kutuplamasını uygulayın. Kapatırken önce dren kutuplamasını kaldırın.

Vg: C = 10 µF

RF özellikleri

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	f	8500	-	9600	MHz
Doyum çıkış gücü	-	50	51	-	dBm
Güç kazancı	-	8	9	-	dB
Eklenen güç verimi	-	-	38	-	%
Güç kazancı düzlüğü	-	-	-	±0.8	dB

DC kutuplama ve akım

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Değer	Birim
Dren çalışma gerilimi	-	-	-	-	28	V
Kapı çalışma gerilimi	-	-	-	-	-3	V

Sınır değerler

Sınır değerlerdir; normal çalışma hedefleri değildir.

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
En yüksek dren-kaynak gerilimi	-	-	-	32	V
En düşük kapı kutuplaması	-	-5	-	-	V
Depolama sıcaklığı	-	-65	-	150	°C
En yüksek giriş gücü	-	-	-	45	dBm
En yüksek kanal sıcaklığı	-	-	-	200	°C

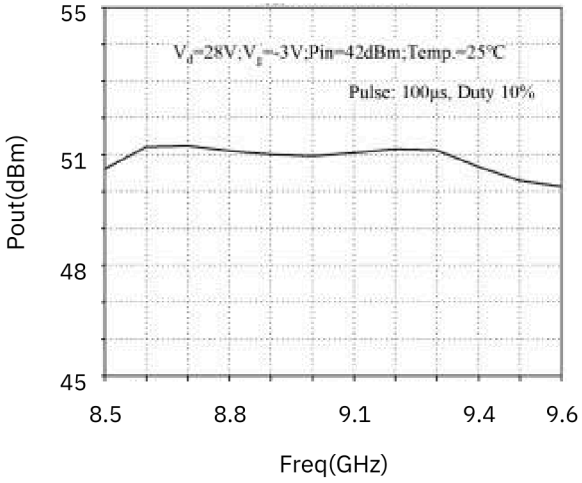
Güncel yayın kaydı · 1.5 · 2026-11-12. Ürün açıklaması veya editoryal içerik güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.4.

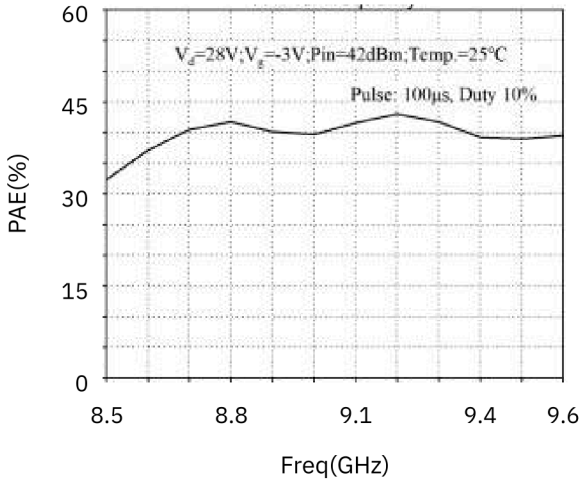
Entegrasyon notları

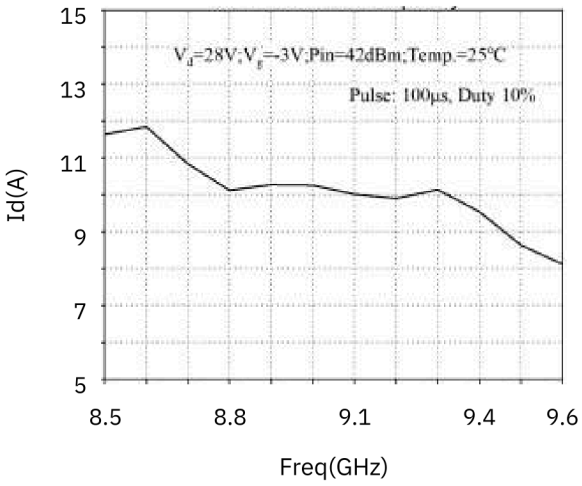
CMW025B Önce kapı, sonra dren kutuplamasını uygulayın. Kapatırken önce dren kutuplamasını kaldırın. Vg: C = 10 µF G: RF girişi D: RF çıkışı S: Kaynak / toprak

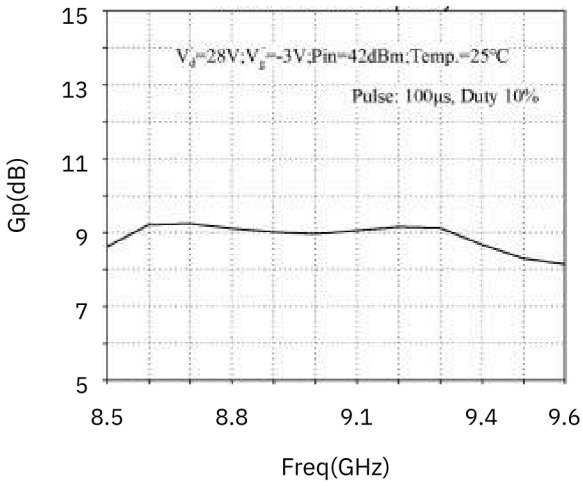
Performans eğrileri

Her şekli, belirtilen çalışma koşullarıyla birlikte değerlendirin.









Çıkış gücü; Eklenen güç verimi; Savak akımı; Güç kazancı. Vd = 28 V; Vg = -3 V; Pin = 42 dBm; TA = 25 °C; PW = 100 µs; D = 10%.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.